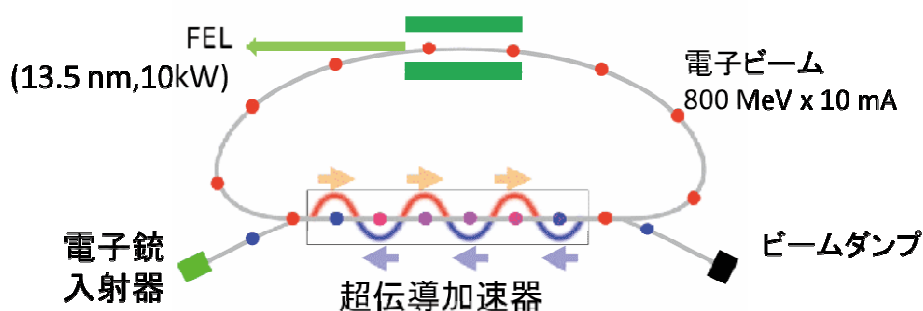


87 EUV自由電子レーザーの開発と半導体リソグラフィ技術への応用

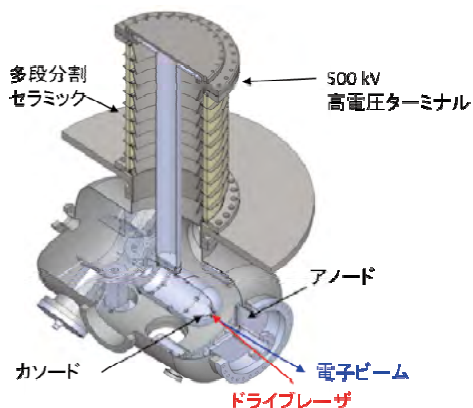
次世代半導体の製造、検査に必要な高出力EUV光源を開発し、高集積半導体作製への応用を目指す。

シーズの特徴（成果含む）

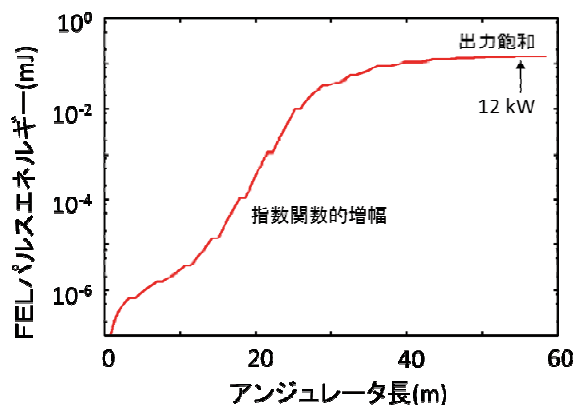
10 kW級EUV光源の概念図



光陰極DC電子銃



FEL発振シミュレーション



○10kW級EUV光源（波長13.5nm）の実現に必要な電子銃、加速器、シミュレーション、自由電子レーザーの技術

アウトカム

半導体集積度の向上

アウトカムに至る段階

応用段階

連携希望企業

東芝、三菱重工MS、日立、NTT-AT、ギガフォトン他半導体メーカー

知財等関連情報

- 1) R. Hajima, Proc. 2014 International Workshop on EUV and Soft X-Ray Sources (Dublin, Nov.3-6, 2014)

担当者

量子ビーム科学部門
高崎量子応用研究所東海量子ビーム応用研究センター
羽島 良一

本シーズの問合せ先：量子ビーム科学部門研究企画部(qubs-techoffice@qst.go.jp)